

بررسی ساختاری و خواص نوری بلور نیوبات لیتیم نفوذدهی شده با روی

غلامرضا نبیونی، لیلا عقلی مقدم و اکبر زنده‌نام

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آراک

علی‌اکبر فراشیانی

گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، تهران

(دریافت مقاله: ۸۹/۲/۵ - پذیرش مقاله: ۸۹/۸/۱۸)

چکیده

تغییر ضریب شکست نور در نوار باریکی از سطح مواد نوری مناسب، موجبرهای نوری را نتیجه می‌دهد. یکی از مشهورترین روش‌های ساخت این موجبرهای نفوذدهی عناصر فلزی مناسب نظیر روی در نوار باریکی از سطح بلور نیوبات لیتیم است؛ پایداری خواص ویژه نیوبات لیتیم در اثای دست‌یابی به بهینه شرایط نفوذ، از اهمیت بسیار برخوردار است. اهداف این تحقیق عبارتند از عملی نمودن نفوذ حرارتی روی در زیرلایه نیوبات لیتیم در بهترین شرایط دما و زمان (نسبت به تحقیقات گزارش شده قبلی) و بررسی مکانیزم نفوذ و مطالعه تاثیرات نفوذ بر خواص بلوری، نوری و مورفولوژی سطح بلور پایه نیوبات لیتیم، لذا ابتدا لایه‌ای از روی به سخامت 150 nm به روش کندوپاش مگترون DC با دمای زیرلایه 127°C بر سطح بلور نیوبات لیتیم لایه‌نشانی شد. سپس به مدت 10 min در دمای 450°C در هوای آزاد اکسایش یافت و در نهایت، در بازه‌ای از دما و زمان‌های مختلف به روش حرارتی به درون بلور نیوبات لیتیم نفوذ داده شد. نتایج آنالیزها حاکی از آن بود که با بکارگیری روش کندوپاش مگترون DC در لایه‌نشانی و اتخاذ تدابیری نظیر افزایش دمای زیرلایه پیش از انباست و نیز اکسایش لایه‌ی انباستی پیش از نفوذ؛ سرانجام تمام مقدار روی، بعد از حرارت دهی به مدت 180 min در دمای 750°C به درون ساختار بلور نیوبات لیتیم نفوذ کرده که نسبت به دما و زمان‌های گزارش شده در تحقیقات مشابه به مراتب بهتر و عملی‌تر است. از سوی دیگر، بلور نیوبات لیتیم در محدوده دما و زمان‌های بکار رفته از پایداری خوبی در ماهیت بلوری و خواص نوری برخوردار بوده است.

واژه‌های کلیدی: نفوذ حرارتی، نیوبات لیتیم، روی، پسپارکنگی راترفورد، اسپکتروفوتومتری.

Optical and Structural Characterization of Zn Diffused Lithium Niobate Crystals

G. Nabiyouni, L. Aghlimoghadam and A. Zendehnam

Department of Physics, Faculty of Science, Arak University, Arak

A. Farashiani

Optical Group, Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran

Abstract

One of the most popular and well-established techniques to fabricate low-loss optical waveguides is diffusing of metal ions into Lithium Niobate (LN) crystals. In this work we reported a 3-steps waveguide fabrication process, based on Zn diffusion into LN. First, a layer of Zn with the thickness of 150 nm was sputtered on a hot (127°C) LN substrate. Then the Zn atoms were oxidized by annealing the sample at 450°C for 10 min . Finally, thermal diffusion of Zn atoms into LN substrate took place in the different annealing temperatures and times. The aim of this work was to find an optimum diffusing temperature and time of Zn into the LN crystal. Structural and optical characterization of the prepared samples were carried out using XRD, RBS combined with channeling, SEM and double beam spectrophotometer.

Our experimental results indicated that almost all of the Zn ions had been diffused into the LN crystal after annealing the sample at 750°C for 180min . The comparative analyses using XRD, RBS combined with channeling and spectrophotometry, revealed a good stability in optical and crystal structure of LN. Optical transmission and band gap energy of the samples were found to vary with the amount of the Zn content, while in the purchased LN crystal, the band gap was about 4eV , it was dropped to around 2.9eV after annealing the sample at 800°C because of diffusing the Zn atoms into the LN crystal. This result promises an improvement on the LN conductivity, therefore an enhancement in its waveguide characteristic.

Keywords: Thermal Diffusion, Lithium Niobate, Zinc, Waveguides, Spectrophotometry.

E-mail of corresponding author: g-nabiyouni@araku.ac.ir

مقدمه

در کلیه روش‌های گزارش شده در بالا، علاوه بر سهولت روش ساخت، پایداری خواص ویژه نیوبات لیتیم حین دستیابی به بهینه دما و زمان نفوذ حرارتی روی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بدین منظور، در این تحقیق از راهکارهای جدیدی در فرآیند لایه‌نشانی و نفوذ حرارتی استفاده نموده‌ایم و همچنین کلیه تغییرات احتمالی ایجاد شده در ساختار بلوری و نوری نمونه‌ها نیز توسط آنالیزهای XRD، RBS، SEM و اسپکتروفوتومتری (Spectrophotometry) مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روش تحقیق

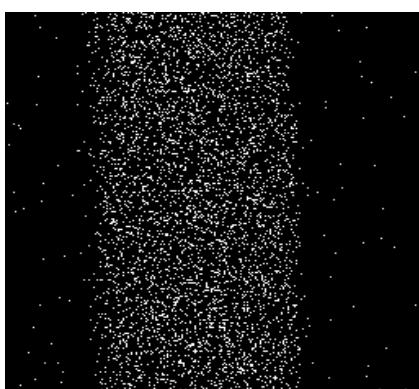
در این تحقیق از بلور نیوبات لیتیم (x-cut) با خلوص ۹۹/۹۹۸٪ (محصول شرکت چینی Foctek)، ضخامت mm ۵/۰ و ابعاد $20 \times 20 \times 10 \text{ mm}^3$ استفاده شد که پس از تهیه، با لیزر Nd-YAG به طول موج 1064\AA برش زده و مساحت آنها به $10 \times 10 \text{ mm}^2$ کاهش یافت. زیرلایه‌ها ابتدا با استن و سپس به مدت ۲min در حمام فراصوتی^۱ با آب جوش و در نهایت با استن و الکل ایزوپروپانول شستشو و با تیغه‌های فلزی ماسک شدند تا مساحت $1 \times 1 \text{ mm}^2$ در آنها ایجاد شود. سپس فلز روی به ضخامت ۱۵۰nm به روش کندوپاش مگنترون DC با دمای زیرلایه 127°C لایه‌نشانی شد.^۲ در مرحله بعد به منظور اکسایش روی، نمونه‌ها در دمای 450°C به مدت ۱۰min در اتمسفر معمولی حرارت‌دهی شده و در پایان، نفوذ حرارتی در دمایها و زمان‌های متفاوت مطابق جدول ۱، انجام شد. شایان ذکر است که به منظور بررسی نقش عامل‌های دما و زمان در ساخت نمونه‌ها، از روش یک متغیر در هر بار استفاده شده است.

به منظور بررسی نفوذ روی و همچنین کیفیت بلوری نیوبات لیتیم، آزمایش‌های RBS و کانال‌زنی [۸] توسط باریکه یون‌های He^+ با انرژی $1/5$ و 2MeV حاصل از شتاب‌دهنده

نفوذ فلز روی در نیوبات لیتیم روش نسبتاً جدیدی در ساخت موجبرهای نوری با توانایی هدایت هر دو مد قطبش (الکتریکی و مغناطیسی) است. تاخیر دریکی از این دو مد باعث PMD (پراکندگی مدقطبشی Mode Dispersion؛ با توجه به دارا بودن ضریب نفوذ بالای روی، نفوذ آن در دماهای نسبتاً پایین (در مقایسه با نفوذ تیتانیم در دمای 1000°C ، بعنوان اولین ماده نفوذی در نیوبات لیتیم به‌منظور ساخت موجبرهای نوری) در حدود $500-900^\circ\text{C}$ انجام می‌شود^[۱]. در این بازه دمایی، نیوبات لیتیم خواص بلوری و نوری اولیه خود را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مقاومت موجبر حاصل در برابر تخریب نورشکستی بالا است^[۲]. استفاده از یون‌های روی، می‌تواند توسط نفوذ از منبع روی/اکسید روی، فاز بخار و یا فاز مایع آن رخ دهد. سوارز و همکارانش در سال ۲۰۰۵ نفوذ روی از فاز بخار آن را طی فرآیند دو مرحله‌ای در نیوبات لیتیم گزارش کردند؛ بدین ترتیب که ابتدا زیرلایه نیوبات لیتیم را به مدت ۲ ساعت در دمای 550°C در محفظه بخار روی قرار داده و سپس نمونه‌های لایه‌نشانی شده را به مدت ۱ ساعت در دمای 900°C در اتمسفر هوای آزاد حرارت دادند^[۳]. نوادو و همکارانش در سال ۲۰۰۱ فرآیند نفوذ دو مرحله‌ای را گزارش کردند که در مرحله اول شامل حرارت‌دهی زیرلایه نیوبات لیتیم در محفظه بخار روی در دمای 550°C به مدت ۲ ساعت و سپس حرارت‌دهی نمونه‌های انباست شده در اتمسفر هوای آزاد به مدت ۴-۸ ساعت در دمای 80°C بود^[۴]. مهم ترین جایگزین نفوذ روی از منبع بخار، نفوذ از لایه فلزی روی انباست شده بر سطح بلور است. این روش توسط لومینگ و همکارانش پس از ۲ ساعت حرارت‌دهی در دمای 890°C با موفقیت بکار برد شد^[۵]. در این راستا، فوجیمورا و همکارانش نیز موجبرهای نیوبات لیتیم روی نفوذی را پس از $5/5$ ساعت حرارت‌دهی در دمای 890°C از منبع اکسید روی انباست شده به روش کندوپاش RF ساختند^[۶].

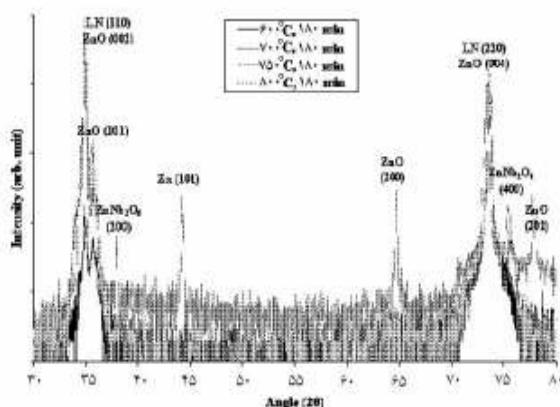
^۱ Ultrasonic bath

^۲ ضخامت لایه انباست شده بر سطح زیرلایه بایستی به اندازه‌ای باشد که در مدت زمان و دمای حرارت‌دهی، کل آن به داخل ساختار بلوری نفوذ کند تا سطح زیرلایه از هرگونه تخریب یا نقص مصنوع بماند^[۷].



شکل ۱. تصویر حاصل از میکروپیکسی، نشان‌دهنده تجمع روی در کاتال حاوی روی در سطح زیرلایه، لایه‌نشانی و اکسید شده به مدت ۱۰ دقیقه در دمای 450°C (پهناهی کanal حاوی روی 1 mm و ابعاد کل نمونه $2\times 2\text{ mm}$ است)

زمان‌های متفاوت نفوذدهی شده‌اند، لذا در روال انجام آنالیزها، می‌توان به بررسی نقش دو عامل دما و زمان پرداخت. در ابتدا به منظور بررسی نقش دمای نفوذ بر ساختار بلوری، طیف XRD حاصل از نمونه‌های نفوذدهی شده در دماهای مختلف و زمان یکسان در شکل ۲ آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، فاز جدید نیوبات روی ZnNb_2O_6 در توافق با گزارش سایر مراجع [۱۱، ۱۰، ۹] تقریباً در کلیه نمونه‌ها در حدود زاویه 38° مشاهده می‌شود. قله‌های مربوط به نیوبات لیتیم و اکسید روی نیز همواره حضور دارند. جابجایی اندک ایجاد شده در محل وقوع قله‌ها در دماهای مختلف را می‌توان ناشی از نفوذ روی به ساختار بلور نیوبات لیتیم و ایجاد اعوجاج اندکی در شبکه بلوری دانست.



شکل ۲. طیف XRD، تغییرات زاویه‌ای لگاریتم شدت، مقایسه نمونه‌های نفوذدهی شده در دماهای مختلف و زمان یکسان

جدول ۱. مشخصات دما و زمان نفوذ حرارتی در نمونه‌های ساخته شده.

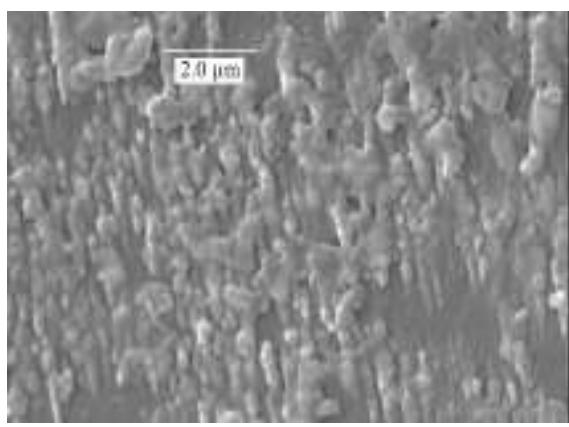
دما ($^{\circ}\text{C}$)	زمان (min)		
	۶۰	۱۲۰	۱۸۰
۶۰۰			۱
۷۰۰			۱
۷۵۰		۱	۱
۸۰۰	۱	۱	۱

واندوگراف 3 MeV استفاده شد. مطالعه ساختاری نمونه‌های نفوذدهی شده به روش پراش اشعه-X توسط دستگاه ۳۳۷۳ Philips X'pert; PW شد. اندازه‌گیری نوری نمونه‌ها توسط تکفام‌گر دو باریکه در محدوده طول موج $200-1100\text{ nm}$ انجام شد. به منظور مطالعه مورفولوژی سطح نمونه‌ها از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل S ۳۶۰ مربوط به Cambridge ۱۹۹۰ استفاده شد.

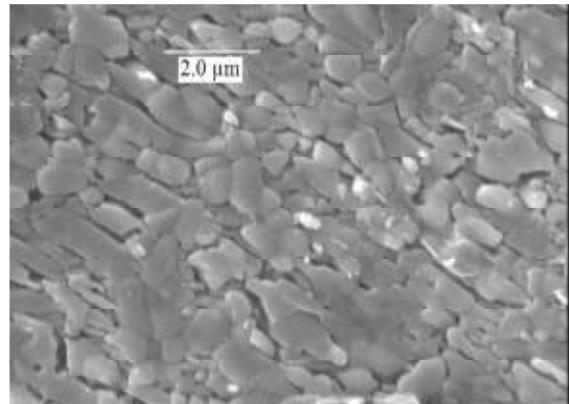
نتایج و بحث

پس از تمیزسازی اولیه زیرلایه‌ها، لایه‌نشانی به روش کندوپاش مگнетرون DC در باریکه به پهنهای 1 mm صورت گرفت که به منظور بررسی کیفیت انباست روی، تجمع روی در کanal و نیز ماسک بکار رفته، تصویر حاصل از آنالیز میکروپیکسی مربوط به نمونه لایه‌نشانی و اکسید شده در شکل ۱ آورده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، عمل لایه‌نشانی در کanal مدنظر با دقت و ظرافت خوبی انجام شده و عملاً توزیع منظم و همگنی از روی در محل کanal مشاهده می‌شود. لازم به ذکر است که با توجه به قطر باریکه He^+ در این آنالیز که معادل $5\mu\text{m}$ می‌باشد، تفکیک و مشاهده یکایک اتم‌ها غیرممکن است و بنابراین نقاط سفید رنگ، اجتماعی از اتم‌های روی هستند.

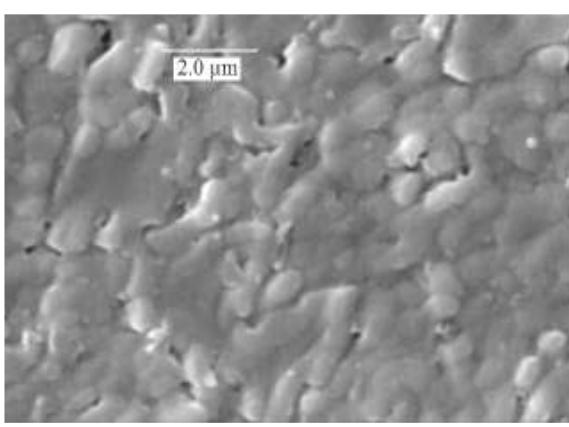
پس از لایه‌نشانی و اکسایش، نفوذ حرارتی و ساخت نمونه‌ها طبق جدول ۱ صورت گرفت. همان‌طور که از جدول مشاهده می‌شود، نمونه‌های موجود در ستون آخر جدول در دماهای مختلف و زمان یکسان، حرارت و نفوذدهی شده‌اند، همچنین نمونه‌های موجود در سطر آخر جدول در دمای یکسان و



شکل ۴. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 700°C زمان 180 min



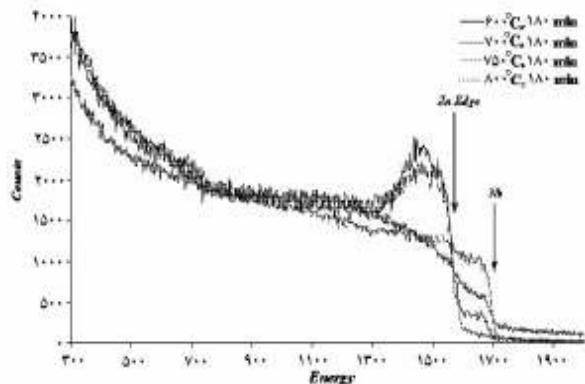
شکل ۵. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 750°C زمان 180 min



شکل ۶. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 800°C زمان 180 min

زیرلایه است. در واقع این نتیجه با نتایج برآمده از طیف‌های RBS مبنی بر تسهیل و یا تسریع نفوذ با افزایش دما در توافق است.

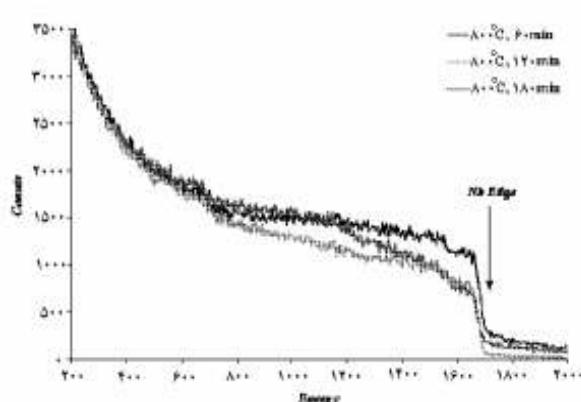
به منظور مطالعه مکانیزم نفوذ و بررسی تاثیر دما بر آن، طیف حاصل از آنالیز پسپراکنده راترفورد حاصل از نمونه‌ها در دماهای مختلف و زمان یکسان، در شکل ۳ آورده شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود طبق انتظار با افزایش دما نفوذ، از میزان روی در لایه کاسته شده و در نتیجه مقدار بیشتری از آن به داخل ساختار نفوذ کرده است (قله موجود در سطح، نشان‌دهنده مقدار زیاد روی است که با افزایش دما ناپدید می‌شود یعنی پخش روی در زیرلایه صورت گرفته است). همچنین با افزایش دما، شب منحنی افزایش یافته که گویای افزایش گرادیان غلظت روی در زیرلایه است، به‌گونه‌ای که در دماهای پایین‌تر فلز روی فقط در سطح زیرلایه نفوذ کرده اما از دما 750°C به اعمق بیشتری از زیرلایه رسیده و در آن پخش بهتری دارد.



شکل ۳. طیف پسپراکنده راترفورد نمونه‌های نفوذدهی شده در دماهای مختلف و زمان یکسان. آنالیز توسط ذرات He^{+} و انرژی 2 MeV در زاویه پسپراکنده

برای مطالعه نقش دمای نفوذ بر تغییرات مورفولوژی سطح، تصاویر تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاصل از کanal روی، به ترتیب در شکل‌های ۴ تا ۶ تا گزارش شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند. کلیه تصاویر با بزرگنمایی $10,000\times$ گرفته شده‌اند.

آنچه در روال افزایش دما مشاهده می‌شود، ایجاد بهبود در ساختار لایه است؛ در ابتدا جزیره‌هایی بر سطح تشکیل شده که با افزایش دما بهم پیوسته‌تر می‌شوند. اجتماع جزیره‌ها به نوعی نشان‌دهنده ریزتر شدن ذرات روی و اکسید روی و در نتیجه وقوع سریع‌تر نفوذ به درون ساختار



شکل ۸ طیف پسپراکنده‌گی راترفورد، نمونه‌های نفوذدهی شده در دمای یکسان 800°C و زمان‌های متفاوت ۶۰min و ۱۲۰min و ۱۸۰min آنالیز RBS توسط ذرات فرودی He^{+} و انرژی MeV انجام شده است.

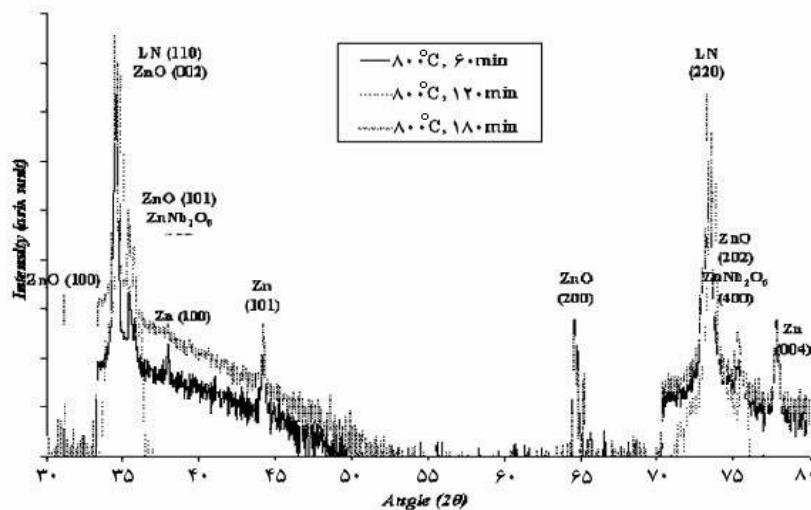
در دماهای پایین‌تر از 800°C است. همچنین ملاحظه می‌شود که با افزایش زمان نفوذ، کاهش منظمی در مقدار نبیوم موجود ایجاد شده است. گرادیان غلظت عنصر روی موجود در سطح زیرلایه نیز با افزایش زمان، افزایش یافته که نشان‌دهنده پخش بیشتر و بهتر آن در ساختار زیرلایه است. برای بررسی نقش زمان نفوذ بر تغییرات مورفولوژی سطح، تصاویر تهیه شده از میکروسکوپ الکترونی روبشی حاصل از کanal روی، به ترتیب در شکل‌های ۹ تا ۱۱ گزارش شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

در مرحله دوم برای بررسی نقش زمان نفوذ در ساختار بلوری، طیف‌های حاصل از پراش اشعه-X نمونه‌های نفوذدهی شده در دمای یکسان و زمان‌های مختلف، در شکل ۷، آورده شده‌اند.

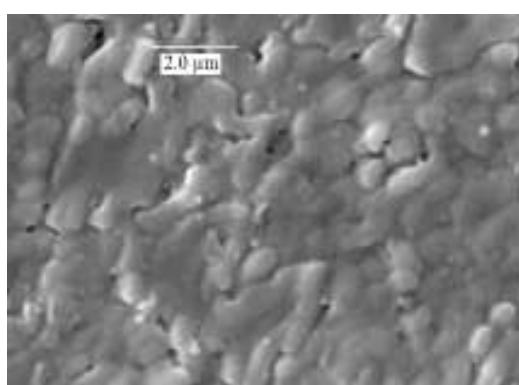
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، محل وقوع قله‌ها در نمونه‌های نفوذدهی شده در زمان‌های ۶۰min و ۱۲۰min از شباهت زیادی با یکدیگر برخوردارند. به نظر می‌رسد تا این زمان، فاز جدید نیوبات روی همچنان بر سطح زیرلایه حضور دارد و اکسید روی نیز در هر دو زمان در راستاهای مشابهی، بر سطح زیرلایه رشد کرده است. اما در نمونه نفوذدهی شده در زمان ۱۸۰min فاز نیوبات روی ناپدید شده و در ضمن برخی راستاهای رشد اکسید روی نیز مشاهده نمی‌شود. این تفاوت می‌تواند ناشی از آن باشد که در زمان ۱۸۰min، نفوذ کامل روی به درون ساختار زیرلایه رخ داده و عملاً مقدار بسیار ناچیزی از فازهای جدید بر سطح باقی مانده است.

به منظور مطالعه مکانیزم نفوذ و بررسی تاثیر زمان در آن، طیف حاصل از آنالیز پسپراکنده‌گی راترفورد با باریکه‌ای از یونهای He^{+} با انرژی ۲MeV مربوط به نمونه‌های نفوذدهی شده در دمای یکسان و زمان‌های متفاوت، در شکل ۸ آورده شده است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در کلیه این نمونه‌ها اثری از قله روی در سطح، مشاهده ننمی‌شود و این در توافق با آنالیز روی



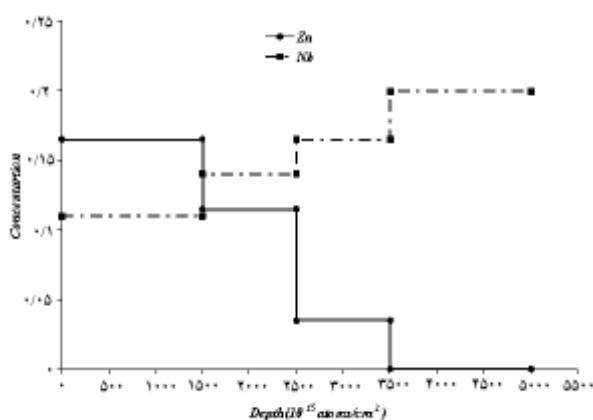
شکل ۷. منحنی تغییرات زاویه‌ای لگاریتم شدت حاصل از مقایسه نمونه‌های نفوذدهی شده در دمای ثابت و زمان‌های مختلف



شکل ۱۱. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 800°C زمان 180 min

در این نمونه با توجه به پایین بودن دمای اعمال شده به نمونه، انتظار می‌رود که عملاً نفوذ روی به اعمق ساختار شبکه نیوبات‌لیتیم رخ نداده و مقدار زیادی از آن، نفوذ نکرده باقی مانده باشد. همان‌گونه که از منحنی نیز ملاحظه می‌شود با پیش‌روی به عمق ساختار و فاصله گرفتن از سطح، به مرور از میزان روی کاسته و به نئوبیم و لیتیم موجود (با فرض شباهت رفتاری این دو عنصر [۱۱، ۱۲]) افزوده شده است. تابع رفتاری عنصر روی به صورت شماتیکی نیمه گوسی به دست آمده که در توافق خوبی با نتیجه تحقیق انجام شده توسط لیفانته و همکارانش می‌باشد [۱۳، ۱۴، ۱۵].

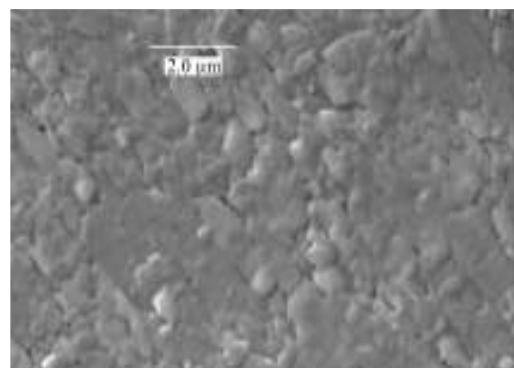
برای نمونه نفوذدهی شده به مدت 120 min در دمای 800°C نیز طبق منحنی ۱۳ مشاهده می‌شود که در سطح نمونه هر سه عنصر روی، نئوبیم و لیتیم (با فرض شباهت رفتاری لیتیم و



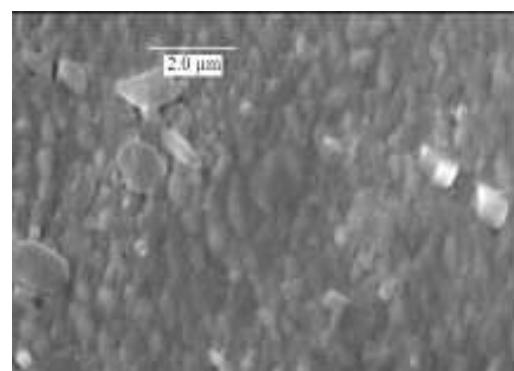
شکل ۱۲. نیم‌رخ غلاظت، نمونه انباست و اکسید شده، دما 450°C زمان 10 min

ابتدا در شکل ۹ به نظر می‌رسد که ساختار، مرحله گذاری را طی کرده، رو به پیوستگی بیشتر می‌رود. حالت جزیره‌ای ساختار به وضوح پیوسته‌تر شده و نواحی بزرگ‌تری در حال تشکیل است. با دقت در شکل ۱۰ ملاحظه می‌شود که با افزایش زمان نفوذ به 120 min ، روال پیوستگی و ریزدانه شدن ساختار تداوم یافته تا اینکه در زمان 180 min طبق شکل ۱۱ از پیوستگی و یکنواختی ساختار، (نسبت به شکل ۱۰) کاسته شده و دوباره رو به جزیره‌ای شدن پیش می‌رود که شاید تاثیر زمان طولانی مکث در دمای 800°C باشد.

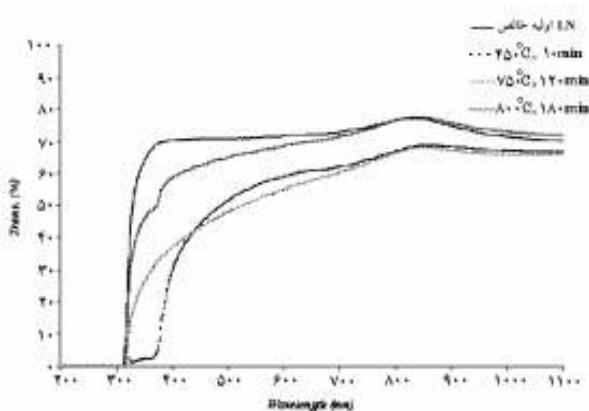
برای مطالعه مکانیزم نفوذ روی در بلور نیوبات‌لیتیم، به کمک آنالیز پس‌پراکندگی راترفورد برای دو نمونه اکسید شده در دمای 450°C در مدت 10 min و دیگری نمونه نفوذدهی شده در دمای 800°C به مدت 120 min ، نیم‌رخ غلاظت عناصر موجود در ساختار، به دست آمد که به ترتیب در شکل‌های ۱۲ و ۱۳ گزارش می‌شوند.



شکل ۹. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 800°C زمان 60 min



شکل ۱۰. تصویر SEM، سطح نمونه نفوذدهی شده، دما 800°C زمان 120 min



شکل ۱۴. طیف عبوردهی، مقایسه‌ی نمونه‌های بدون پوشش و نفوذدهی شده در دماهای مختلف

با توجه به ساختار نیوبات لیتیم و نوع گذار مستقیم در آن، ضریب جذب توسط رابطه (۱) بیان می‌شود [۱۶].

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

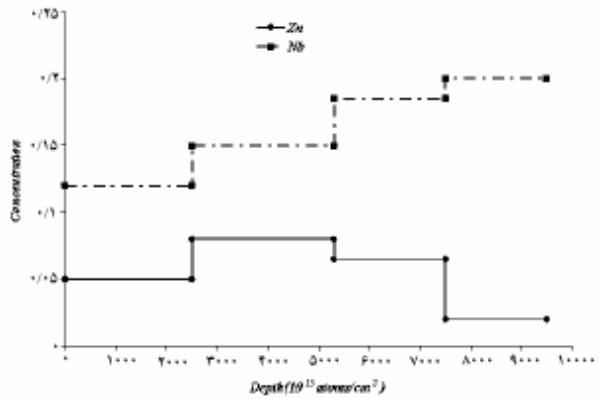
که در آن A مقدار ثابت، $h\nu$ انرژی فوتون و E_g گاف انرژی است. مقدار α نیز تابعی از درصد عبوردهی لایه بوده و از رابطه (۲) به دست می‌آید.

$$\alpha = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) \quad (2)$$

در رابطه (۲)، T میزان عبوردهی لایه انباشتی و زیرلایه، T_0 میزان عبوردهی زیرلایه بدون انباشت و t ضخامت لایه است که معمولاً بر حسب cm بیان می‌شود. طبق رابطه (۱) اگر منحنی ترسیم شود، محل تلاقی خط مماس بر منحنی با محور افقی، اندازه گاف نواری را خواهد داد. بر همین اساس، اندازه گاف نواری برای چهار نمونه: نیوبات لیتیم خام اولیه، نمونه لایه‌نشانی و اکسید شده در دمای 450°C و زمان 10 min و 800°C و زمان 80 min و مدت زمان‌های 120 و 180 min ، توسط منحنی ترسیم شده (۱) اگر $\alpha(h\nu)$ بر حسب $h\nu$ به دست آمد که به ترتیب در شکل‌های ۱۵ تا ۱۸ گزارش می‌شوند.

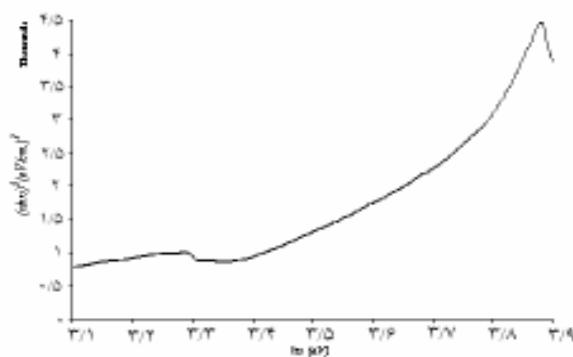
اندازه گاف نواری در نیوبات لیتیم خام اولیه حاصل از شکل ۱۵ حدوداً معادل $3/95\text{ eV}$ به دست می‌آید که در توافق بسیار خوبی با نتایج گزارش شده برای اندازه گاف نواری نیوبات لیتیم در کتب و مراجع است [۱۷].

نوبیم) وجود دارند اگر چه مقدار روی به مراتب کمتر است. با پیش‌روی در عمق نمونه، در ناحیه‌ای مقدار روی به بیشینه‌ای می‌رسد و سپس دوباره از مقدار آن کاسته می‌شود. به عبارتی نیم‌رخ غلظت روی، دارای رفتار شبه گوسی است و این نحوه رفتار با گزارش نوادو و همکارانش در تحقیق مشابه سازگار است [۵].



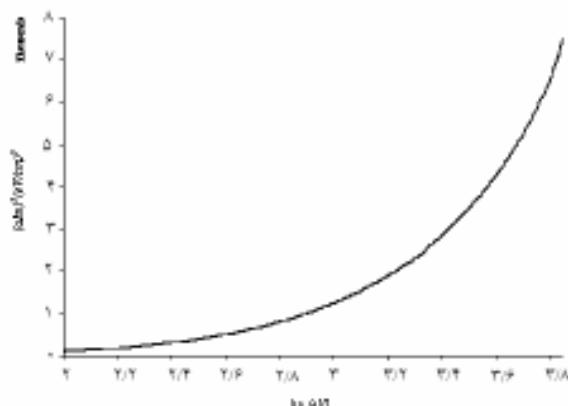
شکل ۱۳. نیم‌رخ غلظت، نمونه نفوذدهی شده، دما 800°C زمان 80 min

به منظور بررسی و مقایسه عبوردهی نوری، طیف‌های حاصل از چهار نمونه: نیوبات لیتیم اولیه، نمونه لایه‌نشانی و اکسید شده در دمای 450°C و زمان 10 min ، نمونه‌های نفوذدهی در دماهای 750°C و 800°C و زمان‌های 120 و 180 min در شکل ۱۴ آورده شده‌اند. ملاحظه می‌شود که میزان عبوردهی برای تمام نمونه‌های نفوذدهی شده نسبت به نیوبات لیتیم خام اولیه، کاهش یافته است که این کاهش می‌تواند به علت وجود روی همچنین جذب در ناحیه فرابنفش نور (محدوده طول موج 450°C - $320-380\text{ nm}$)، تنها در نمونه اکسایش یافته در دمای 450°C (حاوی اکسید روی) ملاحظه می‌شود و در سایر نمونه‌ها، جذب در این ناحیه غیر صفر است. همین امر یعنی جذب در ناحیه مضر نور مرئی، یکی از عمده‌ترین دلایل کاربرد فراوان اکسید روی بر شیشه‌های هوایپیما، عینک‌های آفتابی و نیز کرم‌های ضد آفتاب است. به کمک داده‌های حاصل از منحنی‌های میزان عبوردهی و روابط ۱ و ۲، می‌توان اندازه گاف نواری را در هر یک از نمونه‌ها محاسبه نمود.



شکل ۱۷. نمودار $(\alpha_{hv})^2$ بر حسب (hv) ، نمونه نفوذدهی شده،
دما 750°C ، زمان 120 min

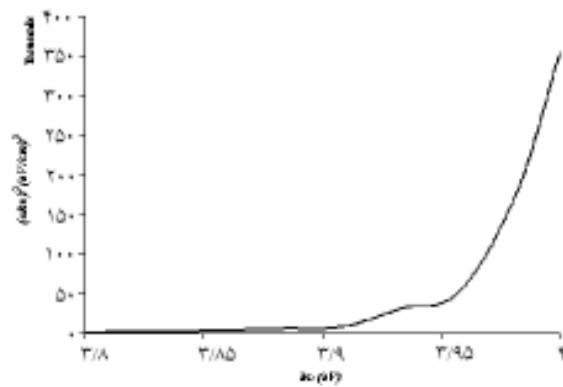
سرانجام در نمونه نفوذدهی شده در دمای 800°C و مدت زمان 180 min که نسبت به تمام نمونه‌ها، حاوی بیشترین مقدار روی و در نتیجه دارای ساختار رساناتری می‌باشد، به کمترین مقدار تقریبی خود یعنی 3 eV تقلیل خواهد یافت (طبق شکل ۱۸). جدول ۲ مقادیر حدودی به دست آمده برای اندازه گاف نواری نمونه‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۱۸. نمودار $(\alpha_{hv})^2$ بر حسب (hv) ، نمونه نفوذدهی شده،
دما 800°C ، زمان 180 min

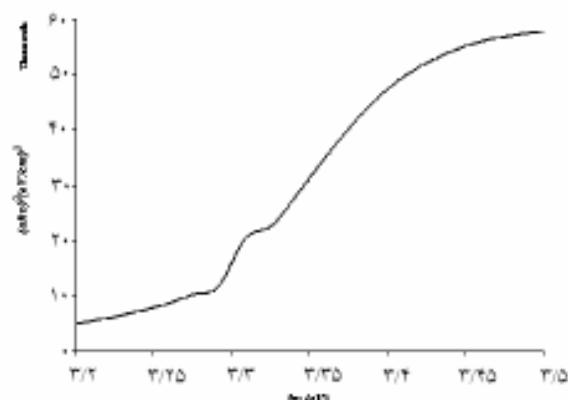
جدول ۲. گزارش اندازه گاف نواری در نمونه‌های حاوی مقادیر متفاوت روی.

نفوذ در 800°C 180 min	نفوذ در 750°C 120 min	نمونه انباست و اکسید شده	نیوبات لیتیم خام	شرایط نمونه
۳	$3/20$	$3/27$	$3/96$	اندازه گاف (eV) نواری



شکل ۱۵. نمودار $(\alpha_{hv})^2$ بر حسب (hv) ، نیوبات لیتیم خام،
دماه معمولی

در شکل ۱۶ که مریوط به نمونه لایه‌نمانی و اکسایش یافته است، اندازه گاف نواری حدوداً معادل $3/27\text{ eV}$ به دست می‌آید که نزدیک به اندازه مشخصه نیمه‌رسانای اکسید روی است [۱۸].

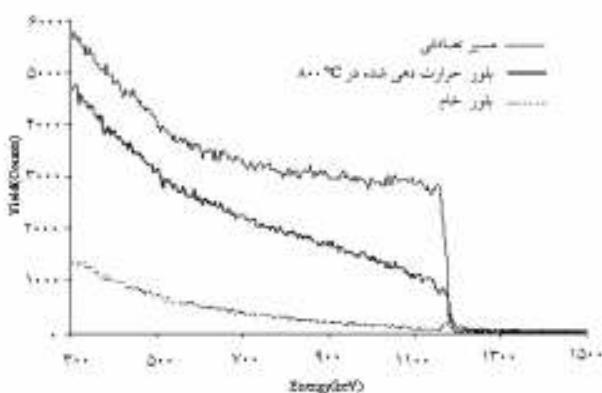


شکل ۱۶. نمودار $(\alpha_{hv})^2$ بر حسب (hv) ، بلور انباستی با روی،
اکسید شده، دما 450°C ، زمان 10 min

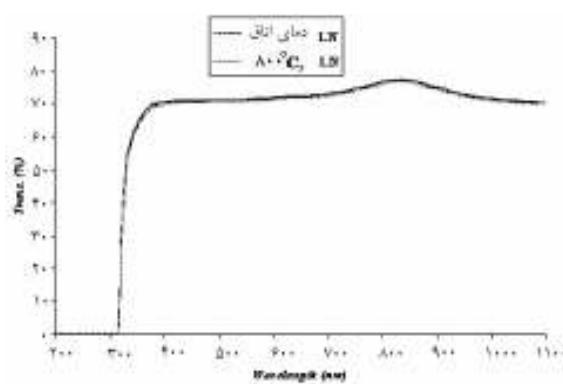
اندازه گاف نواری در نمونه نفوذدهی شده به مدت 120 min در دمای 750°C طبق شکل ۱۷ حدوداً برابر با $3/26\text{ eV}$ به دست می‌آید که نسبت به نیوبات لیتیم خام به مراتب کاهش یافته است. این امر می‌تواند ناشی از حضور یون‌های رسانای روی در ساختار دی‌الکتریک نیوبات لیتیم و در نتیجه، کاهش اندازه گاف نواری ساختار باشد.

شده است. طبق شکل ۲۰ پایداری در ماهیت بلوری و عدم انسداد کanal‌های نیوبات لیتیم، پس از حرارت دهی در دمای 800°C و مدت زمان 180 min نیز تداوم دارد. افزایش بهره به دلیل اثر حرارت بر سطح بلور است.

در شکل ۲۱ طیف حاصل از آنالیز اسپکتروفوتومتری انجام شده بر نمونه‌های نیوبات لیتیم در دمای اتاق (23°C) و دمای 800°C آورده شده است.



شکل ۲۰. طیف حاصل از کanal‌زنی، نیوبات لیتیم حرارت دهی شده، دما 800°C زمان 180 min . آنالیز توسط ذرات He^{+} و انرژی $1/5\text{ MeV}$ در زاویه پراکندگی 165°



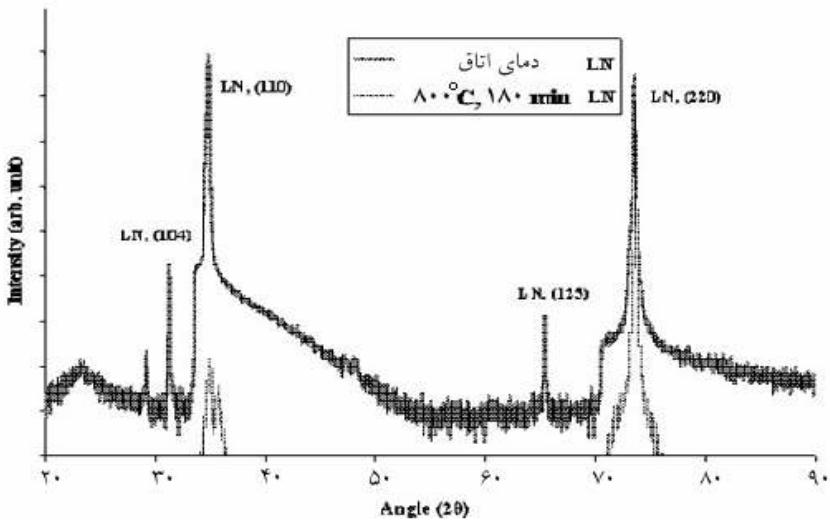
شکل ۲۱. طیف حاصل از کanal‌زنی، نیوبات لیتیم حرارت دهی شده، دما 800°C زمان 180 min . آنالیز توسط ذرات He^{+} و انرژی $1/5\text{ MeV}$ در زاویه پراکندگی 165°

همان‌طور که ملاحظه می‌شود تغییر محسوسی در میزان عبوردهی نیوبات لیتیم ایجاد نشده و عملاً دو طیف بر هم منطبق هستند. با توجه به ارتباط موجود بین میزان عبوردهی و اندازه گاف نواری ساختار طبق روابط ذکر شده در بالا

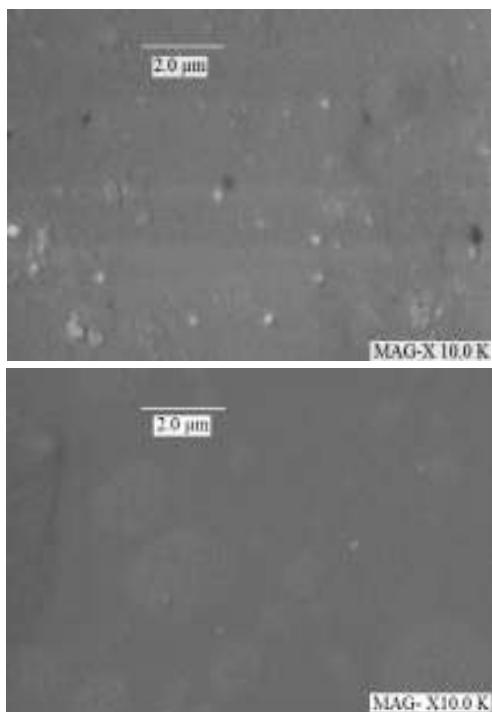
در پایان با توجه به اهمیت پایداری خواص ویژه بلوری، نوری و مورفولوژی سطح نیوبات لیتیم در اثنای نفوذ حرارتی و در بازه دمایها و زمان‌های اعمال شده، آنالیزهای پراش اشعه-X، کanal‌زنی، اسپکتروفوتومتری و تصویربرداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی بر یک نمونه خام اولیه و نمونه نیوبات لیتیم نفوذدهی شده در دمای 800°C انجام شد که به ترتیب گزارش می‌شوند.

طیف‌های حاصل از پراش اشعه-X مربوط به نیوبات لیتیم در دو دمای اتاق (23°C) و نهایی (800°C) در شکل ۱ آورده شده است. در هر دو منحنی، شدت قله‌های مربوط به راستاهای رشد (۱۱۰) و (۲۲۰) بلور نیوبات لیتیم در زوایای $2\theta = 73/4^{\circ}$ و $2\theta = 34/7^{\circ}$ بیشتر است. اما قله‌های کم شدت (۱۰۴) و (۱۲۵) پس از حرارت دهی از بین رفتند. علل احتمالی این امر علاوه بر تفاوت در نحوه قرار گرفتن نمونه در برابر پرتو-X (با توجه به غیر پودری بودن نمونه)، می‌تواند به ضعیف بودن بیش از حد این قله‌ها نسبت به دو راستای مرجح (۱۱۰) و (۲۲۰) باشد. در هر صورت راستای رشد جدیدی مبنی بر تشکیل فاز اضافی در سطح مشاهده نمی‌شود. این امر نشانه‌ای از پایداری ساختار بلوری در اثر حرارت دهی است و با گزارش مراجع [۲۰، ۱۹، ۵]، مبنی بر پایداری و دمای بحرانی بالای بلور نیوبات لیتیم در توافق می‌باشد.

طیف حاصل از کanal‌زنی بلور خام نیوبات لیتیم بدون بازپخت و حرارت داده شده در دمای 800°C در شکل ۲۰ آورده شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که ساختار نیوبات لیتیم خام در دمای معمولی دارای ماهیت بلوری بسیار خوب می‌باشد و گستردگی بازه انرژی (ناشی از عدم اتلاف)، نشان‌دهنده پیش‌روی باریکه تا اعمق زیاد در کanal‌ها و عاری بودن آنها از هر گونه نواقص و ناخالصی است. همچنین مقایسه ذرات برگشتی شمارش شده در طیف کاتورهای با طیف کanalی نشان می‌دهد که کاهش ذرات شمارش شده بیش از ده مرتبه است بنحوی که این درصد کاهش ذرات در راستای بلوری، نشانه‌ای از کیفیت بسیار خوب بلور است. به منظور مقایسه طیف کanalی مربوط به بلور حرارت داده نشده نیز نشان داده



شکل ۱۹. طیف XRD. تغییرات زاویه‌ای لگاریتم شدت، نیوبات لیتیم در دمای معمولی و حرارتدهی شده، دما 800°C زمان 180 min



شکل ۲۱. تصویر SEM، سطح نیوبات لیتیم (چپ) در دمای معمولی؛ (راست) حرارتدهی شده به مدت 180 min در دمای 800°C

پرداخته شد. آنالیزهای پراش اشعه-X، کانالزنی، اسپکتروفوتومتری و همچنین تصویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی رویشی که بر بلور پایه نیوبات لیتیم انجام شد، نشان‌دهنده پایداری خواص بلوری، نوری و مورفلوژی آن در محدوده دمایی به کار رفته برای نفوذ بود. نتایج حاصل از آنالیز پراش اشعه-X به منظور بررسی نقش دما و زمان بر

روابط (۱) و (۲)-۱ می‌توان به ثبات اندازه گاف نواری ساختار بلور نیوبات لیتیم در اثر حرارتدهی در بازه دمایی به کار رفته در این تحقیق پی برد. این امر در توافق با گزارش مراجع [۲۱] نشان‌دهنده پایداری نوری بلور نیوبات لیتیم و مبنی بر بالا بودن دمای بحرانی نیوبات لیتیم (بین 1100 تا 1180°C) است. در شکل ۲۲، تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی رویشی با بزرگنمایی $10,000$ از بلور نیوبات لیتیم خام در دمای معمولی و حرارتدهی شده در دمای 800°C آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سطح بلور پس از حرارتدهی نیز دارای دانه‌بندی کاملاً ریز و یکنواخت است. نقاط سفید رنگی که در تصاویر ملاحظه می‌شود، مربوط به آلدگی‌ها و مواد به‌جامانده از مراحل آماده‌سازی نمونه شامل سونش^۱ و برآق‌سازی^۲ است.

نتیجه‌گیری

در این تحقیق برای به‌دست آوردن بهینه دما و زمان نفوذ کامل روی در زیرلایه نیوبات لیتیم و همچنین مطالعه مکانیزم نفوذ و اثرات آن بر خواص بلوری، نوری و مورفلوژی بلور پایه، به بررسی عملی نفوذ حرارتی روی در زیرلایه نیوبات لیتیم

¹Etch

²Polish

منابع

1. R. Nevado, C. Seda, F. Segato, F. Caccavale, A. Kling, J.C. Soares, E. Cantelar, F. Cusso and G. Lifante, *Compositional characterization of Zn-diffused lithium niobate waveguides*, Applied Physics B, 73(2001)555-558.
2. L. Arizmendi, *Photonic applications of lithium niobate crystals*, Physica Status Solidi A, 201, No. 2, (2004) 253-283.
3. T. Volk, B. Maximov, S. Sulyanov, N. Rubinina and M. Wohlecke, *Optical Materials* 23(2003)229. Jia-Ming Liu, *Photonic Devices*, Cambridge University Press, (2005).
4. H. Yamamoto, N. Saiga, K. Nishimori, *ZnO thin films deposited on various LiNbO₃ substrates by RF-sputtering*, Applied Surface Science ,169-170(2001)517-520.
5. I. Suarez, R. Matesanz, I. Aguirre de Carcer, P.L. Pernas, F. Jaque, R. Blasco and G. Lifante, *Antibody binding on LiNbO₃:Zn waveguides for biosensor applications*, Sens. Actuators B, 107(2005)88-92.
6. R. Nevado and G. Lifante, *Low-Loss, Damage-Resistant Optical Waveguides in Zn-Diffused LiNbO₃ by a Two-Step Procedure*, Applied Physics A, 72 (2001) 725-728.
7. L. Ming, C.B.E. Gawith, K. Gallo, M.V. O'Connor, G.D. Emmer- son and P.G.R. Smith, *High conversion efficiency single-pass second harmonic generation in a zinc-diffused periodically poled lithium niobate waveguide*, Opt. Express, 13(2005)4862-4868.
8. T. Suhara, M. Fujimura and M. Uemukai, *Waveguide Nonlinear-Optic Wavelength Conversion evinces and Their Applications, Photonics Based on Wavelength Integration and Manipulation*. IPAP Books, 2(2005)137-150.
9. C. Cohen and D. Dauvergne, *High energy ion channeling. Principles and typical applications*, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 225(2004)40-71.
10. V.A. Fedorov, Yu.N. Korkishko, G. Lifante and F. Cusso, *Optical and structural haracterization of Zinc vapour diffused waveguides in LiNbO₃ crystals*, Journal of the European Ceramic Society 19(1999)1563-1567.
11. I. Sayago, M. Aleixandre, L. Ares, M.J. Fernandez, J.P. Santos, J. Gutierrez and M.C. Horrillo, *The effect of the oxygen concentration and the rf power on the zinc oxide films properties deposited by magnetron sputtering*, Applied Surface Science, 245(2005)273-280.
12. Y. Wang, H. Wang, S. Li, S. Zhou, Y. Hang, J. Xu, J. Ye, S. Gu and R. Zhang, *Annealing effect on properties of Zno thin films grown on LiNbO₃ substrates by MOCVD*, Journal of Crystal Growth, 284(2005)319-323.
13. R. Nevado, C. Seda, F. Segato, F. Caccavale, A. Kling, J.C. Soares, E. Cantelar, F. Cusso, G. Lifante, *Compositional characterization of Zn-diffused lithium niobate waveguides*, Applied Physics B, 73(2001)555-558.

نفوذ، گویای تشکیل فازهای جدید و ناپایدار سطحی بر بلور نیوبات لیتیم بوده، همچین تغییرات اندکی در مکان قلهای ایجاد شد که می‌توان آن را به جاگیر شدن روی در شبکه بلوری و اعوجاج اندک آن (طبق رابطه شر-دبای) منتسب نمود. آنالیز پس‌پراکندگی راترفورد نیز نشان داد که در دمای ۷۵۰°C و مدت زمان ۱۸۰ min نفوذ کامل روی در نیوبات لیتیم رخ می‌دهد که نسبت به دماهای گزارش شده تاکنون، به مراتب پایین‌تر و مطلوب‌تر است. همچنین با افزایش دما و زمان نفوذ از میزان نئویم و لیتیم موجود در ساختار بلور کاسته شده و بر گرادیان غلظت روی افزوده می‌شود. تخمین عمق نفوذ در دو نمونه حرارت‌دهی شده در دماهای ۴۵۰°C و ۸۰۰°C نشان‌دهنده نیم‌رخ شبه گاوی و در توافق با گزارشات مشابه است. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز گویای آن است که با افزایش دما و زمان حرارت‌دهی، ابتدا ساختار ناحیه حاوی روی رو به بهبود، یکنواختی و ریز دانه شدن می‌گذارد اما این روال تا پایان تداوم نداشته و پس از رسیدن به دما و زمان خاصی متوقف می‌شود. بررسی‌های نوری انجام شده بر نمونه‌ها و محاسبه اندازه گاف نواری نیز کاهش اندازه گاف نواری ساختار را با افزایش میزان روی موجود نشان می‌دهد.

تشکر و قدردانی

این تحقیق به کمک حمایت‌های مادی و معنوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC) انجام شده است. از زحمات دست اندکاران در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده علوم هسته‌ای نیز تشکر و قدردانی به عمل می‌آید.

properties deposited by magnetron sputtering, Applied Surface Science, 245(2005)273-280.

12. Y. Wang, H. Wang, S. Li, S. Zhou, Y. Hang, J. Xu, J. Ye, S. Gu and R. Zhang, *Annealing effect on properties of Zno thin films grown on LiNbO₃ substrates by MOCVD*, Journal of Crystal Growth, 284(2005)319-323.
13. R. Nevado, C. Seda, F. Segato, F. Caccavale, A. Kling, J.C. Soares, E. Cantelar, F. Cusso, G. Lifante, *Compositional characterization of Zn-diffused lithium niobate waveguides*, Applied Physics B, 73(2001)555-558.

14. M. Quintanill, E. M. Rodríguez, E. Cantelar, F. Cussí, C. Domingo, *Micro-Raman characterization of Zn-diffused channel waveguides in Tm^{3+} : $LiNbO_3$* , Optics Express, 18(2010)5449-5458.
15. R. Nevado, C. Sada, F. Segato, F. Caccavale, A. Kling, J.C. Soares, E. Cantelar, F. Cusso, G. Lifante, *Compositional characterization of Zn-diffused lithium niobate waveguides*, Applied Physics B, 73(2001)555-558.
16. L. Zhao, X. Wang, B. Wang, W. Wen and T.Y. Zhang, *ZnO-doped $LiNbO_3$ single crystals studied by X-ray and density measurements*, Applied Physics B, 78(2004)769-774.
17. Y. Caglar, S. Ilcan, M. Caglar and F. Yakuphanoglu, *Effects of In, Al and Sn dopants on the structural and optical properties of ZnO thin films*, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 67, Issues 3-4, (2007)1113-1119.
18. O. Beyer, D. Maxein, K. Buse, B. Sturman, H. T. Hsieh and D. Psaltis, *Femtosecond time-resolved absorption processes in lithium niobate crystals*, Optics Letters, Vol. 30, Issue, 11 (2005)1366-1368.
19. M.H. Aslan, A.Y. Oral, E. Mensur, A. Gul and E. Basaran, *Preparation of c-axis-oriented zinc-oxide thin films and the study of their microstructure and optical properties*, Solar Energy Materials & Solar Cells, 82(2004)543-552.
20. M. Pollnau and Y. E. Romanyuk, *Optical waveguides in laser crystals*, Comptes Rendus Physique, 8(2007)123-137.
21. E. L. Wooten, K. M. Kiss, A. Yi-Yan, J. Murphy, D. A. Lafaw, F. Hallemeier, D. Maack, D. V. Attanasio, D. J. Fritz, G. J. McBrien and D. E. Rossi, *A review of lithium niobate modulators for fiber-optic communications systems*, IEEE Journal. of Selected Topics in Quantum Electronics, 6(2000)69-82.